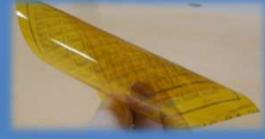
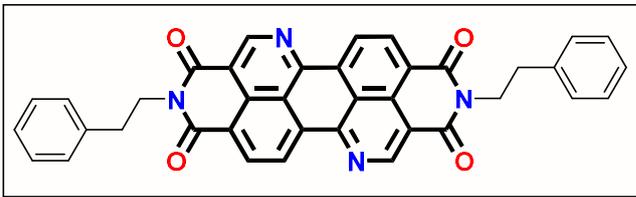


半導体

n型有機半導体材料
PhC2-BQQDI

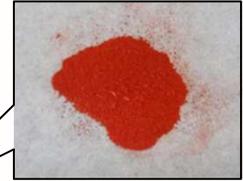


本品は、電子移動度および環境ストレス耐性に優れた実用的な高性能n型有機半導体材料です。真空蒸着法および塗布成膜法どちらでもご使用いただけます。尚、本品は東京大学竹谷教授、岡本准教授と富士フイルム㈱により共同開発された新規材料です。



benzo[de]isoquinolino[1,8-gh]quinoline diimide (BQQDI) 骨格

n=2 PhC2-BQQDI
n=3 PhC3-BQQDI



特長

- ◇高移動度 塗布結晶化による単結晶において大気下で $3 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ の電子移動度
真空蒸着膜において大気下で $0.6 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ を超える電子移動度
- ◇高耐性 単結晶OFETにおいて基板を選ばない 150°C を超える高熱ストレス耐性
良好なバイアスストレス耐性
- ◇高安定性 デバイス構造によらない長期大気安定性：
単結晶OFETにおいて半年以上、蒸着OFETにおいても一か月以上
移動度の減少率わずか10%未満

塗布性単結晶OFET

